

## 研究評価委員会

「ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発  
—窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発」（中間評価）

### 第1回分科会

日時：平成21年8月31日（月曜日）10:00～16:50

場所：NEDO日比谷オフィス

（〒100-0011 千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル4階）

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. 開会、分科会の設置について、資料の確認          | 10:00～10:10 |
| 2. 分科会の公開について                   | 10:10～10:20 |
| 3. 評価の実施方法について                  | 10:20       |
| 4. 評価報告書の構成について                 | ～10:30      |
| 5. プロジェクトの概要（説明50分、質疑40分）       | 10:30～12:00 |
| 5-1. 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメントについて | 10:30～10:50 |
| 5-2. 研究開発成果、実用化の見通しについて         | 10:50～11:20 |
| 5-3. 質疑                         | 11:20～12:00 |
| （昼食 60分）                        |             |
| 6. プロジェクトの詳細（各テーマ説明30分、質疑30分）   | 13:00～16:10 |
| 6-1. 高品質大口径単結晶基板の開発             | 13:00～14:00 |
| 6-2. 高品質大口径エピタキシャル成長技術の開発       | 14:00～15:00 |
| （休憩 10分）                        |             |
| 6-3. 窒化物半導体単結晶基板上電子デバイスの作製と評価   | 15:10～16:10 |
| 7. 全体を通しての質疑                    | 16:10～16:20 |
| 8. まとめ・講評                       | 16:20～16:40 |
| 9. 今後の予定、その他                    | 16:40～16:50 |
| 10. 閉会                          | 16:50       |